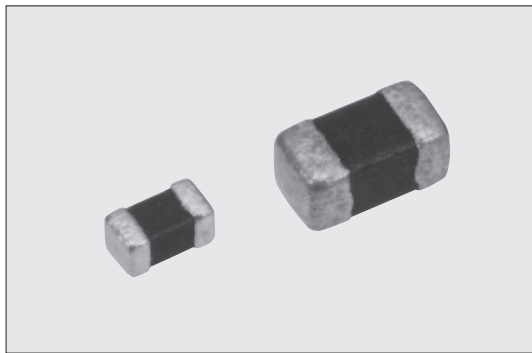


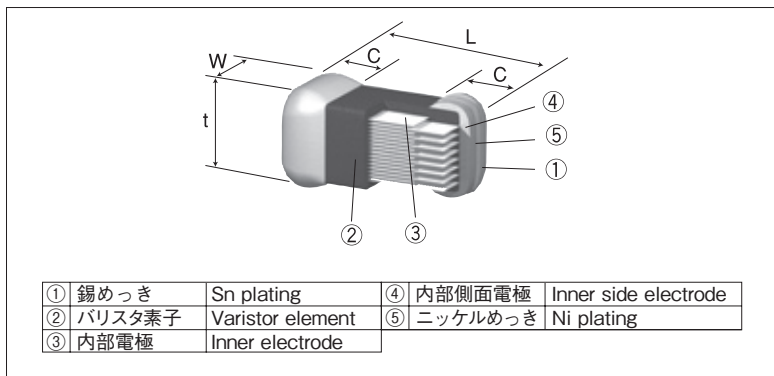
NV73 1H/1E 積層形金属酸化物バリスタ

Multilayer Type Metal Oxide Varistors



外装色：黒 Body color : Black

■構造図 Construction



■特長 Features

- 面実装の0603・1005サイズ金属酸化物バリスタです。
- 優れた応答性でESD対策に好適 (IEC61000-4-2準拠)。
- 3pFも対応可能。
- 電極部は鉛フリーめっきです。
- 双方向のノイズ吸収が可能です。
- リフローはんだ付けに対応します。
- 欧州RoHS対応品です。電極、バリスタ素子、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
- SMD type metal oxide varistors (0201 and 0402 inch size).
- Ideal for countermeasures against ESD with excellent responsivity (Conforming to IEC61000-4-2).
- 3pF available.
- Pb-free solder on terminal section.
- Two-way noise can be absorbed.
- Suitable for reflow soldering.
- Products meet EU-RoHS requirements. EU-RoHS regulation is not intended for Pb-glass contained in electrode, varistor element and glass.

■寸法 Dimensions

形名 Type (Inch Size Code)	寸法 Dimensions (mm)				Weight (g) (1000pcs)
	L	W	t	c	
NV73A1H (0201)	0.6±0.03	0.3±0.03	0.3±0.03	0.1min.	0.299
NV73A□1E (0402)	1.0±0.1	0.5±0.1	0.6 max.	0.25±0.15	1.295

■用途 Applications

- 携帯電話、DSC、コンピュータ、PDA、I/O、等。
- Cellular-telephones, DSCs, Computers, PDAs, I/O, etc.

■品名構成 Type Designation

例 Example

NV73	A	L	1E	T	TP	12
品種 Product Code	エネルギーコード Energy Code	静電容量タイプ Capacitance Type	サイズ Size	端子表面材質 Terminal Surface Material	二次加工 Taping	バリスタ電圧 Varistor Voltage
		空欄：標準品 Nil : Standard type L : 低静電容量タイプ L : Low capacitance type	1H : 0.6×0.3mm 1E : 1.0×0.5mm	T : Sn	TBM : 2mm pitch press paper (1H) TP : 2mm pitch paper (1E)	8 : 8V 12 : 12V 120 : 120V

環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問合せください。
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照してください。

Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the substance specified by EU-RoHS.

For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.

■定格 Ratings

動作温度範囲 Operating Temperature Range : -40°C ~ +85°C

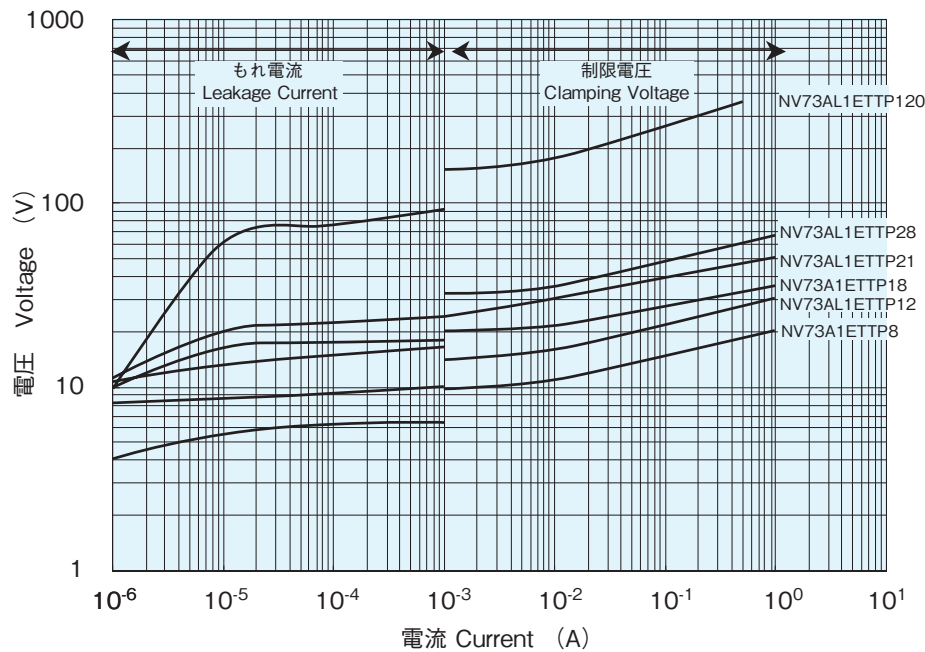
保存温度範囲 Storage Temperature Range : -40°C ~ +125°C

包装数/リール Q'ty / Reel 1H : TBM (15,000pcs)、1E : TP (10,000pcs)

品名 Type	バリスタ電圧 Varistor Voltage V _{1mA} (V)	バリスタ電圧許容値 Varistor Voltage Tolerance (V)	最大許容回路電圧 Max. Allowable Voltage d.c. (V)	制限電圧 Clamping Voltage I _c =1A (V) 8/20μs	エネルギー耐量 Max. Energy (J) 10/1000μs	サージ耐量 Max. Peak Current (A) 2 times 8/20μs	静電容量 (代表値) Capacitance (Typ) 1kHz (pF)
NV73A1HTTBM12	12	10~15.6	6.5	35	0.01	1	33
NV73A1ETTP8	8	6.4~9.6	5.5	20	0.05	20	480
NV73A1ETTP18	18	16.2~19.8	14	35	0.05	20	160
NV73AL1ETTP12	12	10~14	5.5	30	0.03	5	50
NV73AL1ETTP21	21	18~24	14	50	0.03	5	50
NV73AL1ETTP28	28	24~32	18	65	0.005	2	15
NV73AL1ETTP120	120	90~150	18	350 (I _c =0.5A)	0.005	0.5	3 (1MHz)

■電圧-電流曲線(参考) Voltage-Current Curves (Reference) (Ta=25°C)

NV73A1E



チップバリスタ
Chip Varistors

■性能 Performance

試験項目 Test Items	規格値 Performance Requirements $\Delta V \pm \%$	試験方法 Test Methods
バリスタ電圧 Varistor Voltage	規定の許容差内 Within specified tolerance	1mAを流した時の端子間電圧 Voltage between terminals when 1mA is flowed.
はんだ付け性 Solderability	端子電極が95%以上新しいはんだで覆われる事 95% coverage min.	230°C ± 5°C, 4s ± 1s
はんだ耐熱性 Resistance to soldering heat	10	260 ± 5°C, 10s ± 0.5s
温度急変 Rapid change of temperature	10	-40°C (30min) / +125°C (30min) 30cycles
サージ耐量 Maximum peak current	10	定格の衝撃波電流 (T=8/20μs) を正逆各1回印加 A single standard impulse of 8/20μs, positive/negative applied once each
エネルギー耐量 Maximum energy	10	定格のエネルギー (T=10/1000μs) を1回印加 A single standard impulse of 10/1000μs, once
高温直流電圧印加 High temperature life with d.c. bias	10	85°C ± 5°C、Vc=最大許容回路電圧 (Vd.c.) 1000h Load: Maximum Allowable Voltage (d.c.)
高温高湿電圧印加 High temperature & high humidity life with d.c bias	10	40°C ± 5°C、95%RH Vc=最大許容回路電圧 (Vd.c.) 500h Load: Maximum Allowable Voltage (d.c.)
静電容量 Capacitance	代表値 Typical	1kHz : Others 1MHz : Varistor voltage 120V
高温保存 High temperature storage life	10	125°C ± 5°C, 1000h
低温保存 Low temperature storage life	10	-40°C ± 5°C, 1000h